

【お知らせ】研究成果にかかる知的財産権の保護・活用に対する取組について

令和元年6月11日
国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）

＜基本的考え方＞

JSTの「知財活用支援事業」では、権利化支援(大学等所有知財の外国出願支援)、大学・JST事業の知財マネジメント強化の支援、JST所有知財パッケージ化/企業へのライセンス、産学マッチング機会の提供等を実施しています[1]。

本事業においては、JSTのファンディングによる大学等の研究成果が新たな社会的・経済的価値の創出に寄与していくために必要な権利化も大学等と連携して推進しております。

さらに、JSTが保有することになった知的財産権については、パッケージ化、企業へのライセンスを推進するとともに、ライセンシーである企業の方々に安心して利用していただけるように保護することが重要と考えます。

これらの認識に立ち、JSTが保有する知的財産権の保護・活用の支障となりうる場合には、必要に応じ、発明者、法的対応の専門家とともに、当該権利の有効性を示す対応をとっております。

＜保護・活用に対する取組の一例＞

東京工業大学の細野秀雄教授（現在、同大学栄誉教授および元素戦略研究センター長）らが発明した「IGZO系酸化物半導体 TFT (In-Ga-Zn-O を中心とする酸化物半導体を活性層とする薄膜トランジスタ)」の特許群（以下、IGZO 特許群という）[2]は、JSTの創造科学技術推進事業（ERATO）から得られた成果を核とし、国内外の複数のメーカーとの間で、ライセンス契約の締結、もしくは締結の合意に向けた交渉等を行っています。

IGZO 特許群に含まれる一部の特許につきましては、平成26年（2014年）頃より、株式会社半導体エネルギー研究所（住所：神奈川県厚木市長谷398、代表者：代表取締役山崎舜平）が権利者であるJST等を相手に、日本、韓国、台湾及び欧州において無効審判請求や異議申立等をするなどして上記特許の有効性を争ってきましたが、いずれの国においても上記特許の有効性が確認されました。株式会社半導体エネルギー研究所は、日本及び韓国においては、上記特許の有効性を確認する審決に対して、審

決取消訴訟を提起しましたが、上記特許の有効性が判決によっても確認され、平成 31 年（2019 年）4 月 13 日をもって、すべての事件が終了しました。

これにより、JST とライセンス契約を締結されたメーカー様におかれましては、これまでと同様に上記 IGZO 特許群にかかる発明を安心して実施していただけます。

[1] JST 知財活用支援事業の紹介 <https://www.jst.go.jp/chizai/about.html>

[2] 「IGZO 系酸化物半導体 TFT」の研究・開発・事業化を検討されている企業の皆様、
ならびに「IGZO 商標」に関心のある皆様へ <https://www.jst.go.jp/chizai/IGZO.html>

<本件問い合わせ先>

国立研究開発法人 科学技術振興機構 知的財産マネジメント推進部 知財集約・活用グループ

〒102-8666 東京都千代田区四番町 5 番地 3

Tel : 03-5214-8486 Fax : 03-5214-8417

E-mail : license@jst.go.jp

※お問い合わせの内容によっては、回答に時間を要する場合があります。